a 2004 0097

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам получения пористой поверхности полупроводника.
Сущность изобретения заключается в том, что на поверхность полупроводника наносят маску, селективно покрывающую её, и проводят электрохимическое травление. Новизна изобретения состоит в том, что маска выполнена из фоторезиста.

П. формулы: 1
Фиг.: 1